

Председателю диссертационного совета
Д 002.034.01 на базе
Института аналитического
приборостроения РАН
д.т.н. проф. Курочкину В.Е.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Уважаемый Владимир Ефимович!

Я, Нащекин Алексей Викторович, подтверждаю свое согласие выступить в качестве официального оппонента по диссертационной работе Комиссаренко Филиппа Эдуардовича на тему «Манипулирование нанообъектами и модификация материалов с помощью сфокусированного электронного пучка для создания функциональных наноструктур», представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.01 – Приборы и методы экспериментальной физики.

О себе сообщаю следующие сведения:

Ученая степень: кандидат физико-математических наук

Шифр и наименование

научной специальности: 01.04.07 – Физика конденсированного состояния

Место работы: Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе

Подразделение: лаборатория «Диагностики материалов и структур твердотельной электроники»

Должность: старший научный сотрудник

Почтовый адрес

места работы: 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д.26

Телефон: +7 (812) 292-73-82

E-mail : nashchekin@mail.ioffe.ru

Список основных публикаций по теме диссертации за последние 5 лет:

1. Alexander I. Sidorov, Uliana V. Yurina, Gulnaz R. Rakhmanova, Marina N. Shinkarenko, Oleg A. Podsvirov, Yuri K. Fedorov, Alexey V. Nashchekin. Electron-beam modification

- of optical properties of phosphate glasses with high concentration of silver. Journal of Non-Crystalline Solids 499 (2018) 278–282.
2. Е.С. Бочкарева, А.И. Сидоров, А.В. Нащекин. Модификация поверхности пленки иодида серебра при электронном облучении. ЖТФ, 2018, том 88, вып. 7.
 3. A.I. Sidorov, V.F. Lebedev, A.A. Kobranova, A.V. Nashchekin. Formation of carbon quantum dots and nanodiamonds in laser ablation of a carbon film. Quantum Electronics 48 (1) 45 – 48 (2018).
 4. S. E. Nikitin, V. N. Verbitskiy, A. V. Nashchekin, I. N. Trapeznikova, A. V. Bobyl, E. E. Terukova. Surface texture of single-crystal silicon oxidized under a thin V2O5 layer. Semiconductors, 2017, Vol. 51, Issue 1, pp 104–109.
 5. S. M. Suturin, V. V. Fedorov, A. M. Korovin, N. S. Sokolov, A. V. Nashchekin and M. Tabuchi. Epitaxial Ni nanoparticles on CaF2 (001), (110) and (111) surfaces studied by three-dimensional RHEED, GIXD and GISAXS reciprocal-space mapping techniques. J. Appl. Cryst. 2017, 50, 830–839 (IF 2.57).
 6. М.Е. Компан, С.Е. Никитин, Б.А.-Т. Мелех, А.В. Нащекин. Узкополосная люминесценция меди в присутствии наночастиц золота. Физика твердого тела, 2017, том 59, вып. 12.
 7. E.V. Astrova, A.M. Rumyantsev, G.V. Li, A.V. Nashchekin, D.Yu. Kazantsev, B.Ya. Ber, and V.V. Zhdanov. Electrochemical Lithiation of Silicon with Varied Crystallographic Orientation. Semiconductors, 2016, Vol. 50, No. 7, pp. 963–969.
 9. I.P. Soshnikov, A.A. Semenov, P.Yu. Belyavskii, I.V. Shtrom, K.P. Kotlyar, V.V. Lysak, D.A. Kudryashov, S.I. Pavlov, A.V. Nashchekin, G.E. Cirilin. Fabrication of the Structures with Autocatalytic CdTe Nanowires Using Magnetron Sputtering Deposition. Physics of the Solid State, 2016, Vol. 58, No. 12, pp. 2314–2318.
 10. A.S. Pshenova, D.A. Klyukin, A.V. Nashchekin, and A.I. Sidorov. Migration of silver on the nanoporous glasses surface under the action of an electric field // Applied Optics. Vol. 56, Issue 10, pp. 2821-2825.
 11. E. V. Astrova, A. M. Rumyantsev, G. V. Li, A. V. Nashchekin, D. Yu. Kazantsev, B. Ya. Ber, V. V. Zhdanov. Electrochemical lithiation of silicon with varied crystallographic orientation. Semiconductors. July 2016, Volume 50, Issue 7, pp 963–969.

Снс, к.ф.-м.н.



/ А.В. Нащекин /